

2011年6月27日

## STI用CMPスラリーの価格改定の実施

日立化成工業株式会社(本社：東京、執行役社長：田中 一行、資本金：155億円)は、半導体回路平坦化用研磨材(CMPスラリー(注1))のSTI(注2)用につきまして、価格改定を実施することを決定しました。

### 1. 主要原材料の価格高騰の状況

主要原材料であるセリウム化合物の市場価格は、昨夏以降に中国政府のレアアース輸出許可枠が大幅に削減されたことを発端として暴騰いたしました。加えて今年1月に発表された輸出許可枠が、引き続き削減されたことにより、市場価格はさらに高騰を続けており、昨年と比べて数倍以上の高い水準で推移しております。

### 2. 価格改定のお願い

弊社といたしましては、お客様への製品の安定供給を第一優先とし、原材料の確保に努めております。その一方で、当該原材料の価格は昨年以上の高騰を続けており、弊社も採算性改善のための努力を行って参りましたが、残念ながら今回の原材料価格の高騰は自助努力の限界を超えており、お客様に原材料価格上昇分の一部のご負担をお願いせざるを得ないとの結論に至りました。

### 3. 価格改定製品と現行価格に対する改定幅

STI用CMPスラリー 約40%アップ

### 4. 改定時期

2011年8月1日お客様ご発注分より

(注1)CMP(化学的機械研磨：Chemical mechanical planarization)とは、半導体の素子分離工程や回路形成工程上発生した凹凸を研磨、平坦化する技術の事で、CMPスラリーとはこの用途に使用される研磨液のことです。

(注2)STI(Shallow Trench Isolation)は、シリコンウェハー上の何百万個もの半導体素子をそれぞれ電氣的に絶縁する「素子分離」の方法の一つであり、微細配線に適していることからデザインルール180ナノメートル近辺から主流になってきましたが、形成工程上段差が生じるためCMPによる平坦化を行う必要があります。この際、CMPによって発生する研磨傷は歩留りを悪化させるため、30、20ナノメートルとデザインルールの微細化が進展する上では研磨傷のさらなる低減が必須とされています。

以上